

2SB1010

エピタキシャルプレーナ形 PNP シリコントランジスタ
中電力増幅用/Medium Power Amp.
Epitaxial Planar PNP Silicon Transistor

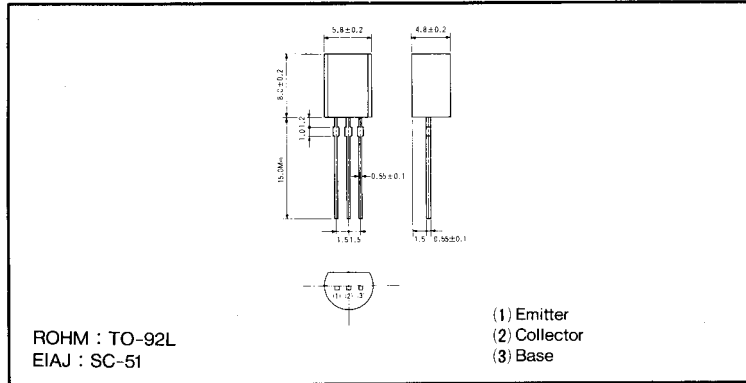
● 特長

- 1) $I_{CP} = -3A$, $P_C = 0.75W$ の大出力。
- 2) Low $V_{CE(sat)}$ である。
Typ. $= -350mV$ at $I_C/I_B = -2A/-0.2A$
- 3) 2SD1384とコンプリである。

● Features

- 1) High output ($I_{CP} = -3A$, $P_C = 0.75W$)
- 2) Low $V_{CE(sat)} = 350mV$ Typ.
at $I_C/I_B = -2A/-0.2A$
- 3) Complementary pair with 2SD1384.

● 外形寸法図/Dimensions (Unit: mm)

● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ C$)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-40	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-32	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-5	V
コレクタ電流	I_C	-2	A
		-3	A (Pulse)
コレクタ損失	P_C	750	mW
接合部温度	T_j	125	$^\circ C$
保存温度範囲	T_{stg}	-55~125	$^\circ C$

● 電気的特性/Electrical Characteristics ($T_a = 25^\circ C$)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV_{CEO}	-32	-	-	V	$I_C = -1mA$
コレクタ・ベース降伏電圧	BV_{CBO}	-40	-	-	V	$I_C = -50 \mu A$
エミッタ・ベース降伏電圧	BV_{EBO}	-5	-	-	V	$I_E = -50 \mu A$
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	-	-	-1	μA	$V_{CB} = -20V$
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	-	-	-1	μA	$V_{EB} = -4V$
直流電流増幅率	h_{FE}	82	-	390	-	$V_{CE}/I_C = -3V/-0.5A^*$
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	-	-0.35	-0.8	V	$I_C/I_B = -2A/-0.2A^*$
利得帯域幅積	f_T	-	100	-	MHz	$V_{CE} = -5V$, $I_E = 0.5A$
コレクタ出力容量	C_{ob}	-	50	-	pF	$V_{CB} = -10V$, $I_E = 0A$, $f = 1MHz$

* パルス測定

 h_{FE} の値により下表のように分類します。

Item	P	Q	R
h_{FE}	82~180	120~270	180~390

● 標準品・準標準品一覧表

(◎:標準品 ○:準標準品)

Type	h_{FE}	包装名	バルク	テーピング
		記号		T103
		基本発注単位 (個)	1 000	2 500
2SB1010	PQR		◎	◎